



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

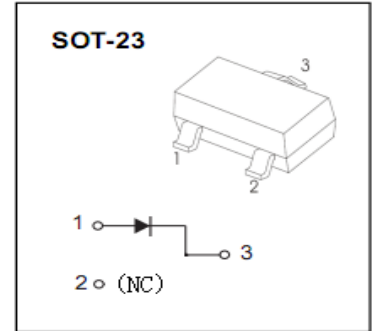
SOT-23 封装半导体二极管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Diodes

MMBD914 (SWITCHING DIODE)

印章/Marking: 5D

特点/Features :

速度快，导通电压低；



极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
不可重复反向峰值电压 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RM}	100	V
反向峰值电压/Peak Repetitive Peak Reverse Voltage 反向工作电压/Working Peak Reverse Voltage 直流阻断电压/DC Blocking Voltage	V_{RRM} V_{RWM} V_R	75	V
平均整流输出电流/Average Rectified Output Current	I_O	300	mA
正向瞬时峰值电流/Peak forward surge Current	I_{FSM}	0.5	A
功率/ Power Dissipation	P_D	0.35	W
热阻/Thermal resistance junction to ambient air	$R_{\theta JA}$	375	°C/W
结温/Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度/ Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数/Parameter	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
反向击穿电压/Reverse Breakdown Voltage	$V_{R(BR)}$	$I_R=100 \mu A$	100		V
正向电压/Forward Voltage	V_{F1}	$I_F=1mA$		0.715	V
	V_{F2}	$I_F=10mA$		0.855	V
	V_{F3}	$I_F=50mA$		1.0	V
	V_{F4}	$I_F=150mA$		1.25	V
反向漏电流/Reverse Current	I_{R1}	$V_R=75V$		1	μA
	I_{R2}	$V_R=20V$		25	nA
端电容/Capacitance Between Terminals	C_T	$V_R=0V, f=1MHz$		2	pF
反向恢复时间/Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F=I_R=10mA,$ $I_{rr}=0.1 \times I_R$		4	nS



典型特性曲线图/Typical Characteristics

